



デバイスの試作評価に

- ALD用各種原料ガスの利用により
広範囲な成膜が可能
(SiO₂、Al₂O₃、ZnO 等)
- 標準でRFプラズマ源を搭載
オプションとして水蒸気酸化や
オゾン酸化にも対応
- 原料ガス切替やプラズマ生成などの
成膜シーケンスは自動対応

Atomic Layer Deposition

原子層堆積法 小型研究装置

基本仕様		プロセスガス導入系	
処理方式	枚葉式	金属原料供給 ユニット	定温制御
基板サイズ	直径:150mm 以下 厚さ:3mm 以下	酸化ガス	O ₂ ガス:1系統
基板ヒーター温度	最大 350 °C	パージガス	不活性ガス:1系統
酸化手法	プラズマ酸化	成膜時ガス供給	自動シーケンス
		成膜時高周波印加	パルス印加

販売元:三井物産エレクトロニクス株式会社
〒105-0011
東京都港区芝公園2-4-1
ダヴィンチ芝パークA管10F
TEL:03-6403-5816

製造元:エム・イー・エス・アフティ株式会社
〒192-0918
東京都八王子市兵衛2-35-2
TEL:042-632-8800